

2P3-60

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコンホトトランジスタ Epitaxial Planar NPN Silicon Phototransistor

センサ

ホトトランジスタ

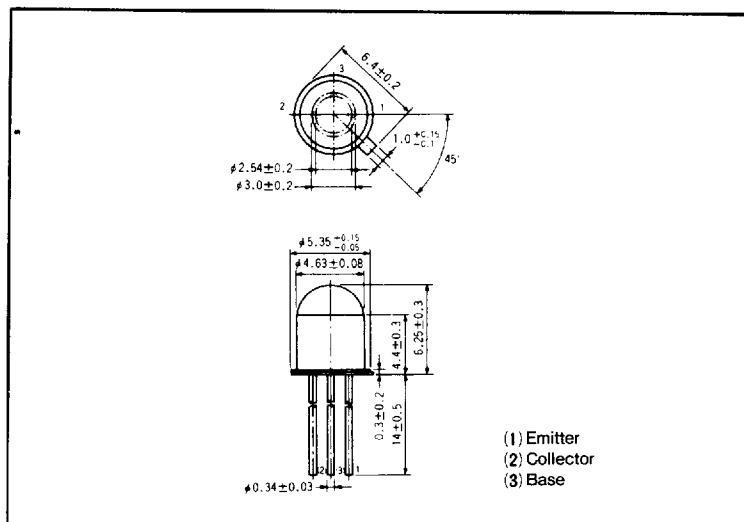
● 特長

- 1) ピーク感度波長 $\lambda_p=800\text{nm}$, 波長入力 600~950nmの光にตอบสนองする。
- 2) 指向感度特性が鋭い。
- 3) 応答速度が速い。
- 4) リニアリティがよい。
- 5) 高信頼度である。

● Features

- 1) Responding to light with 800nm of peak sensitivity wavelength (λ_p) and 600~950nm of spectrum input.
- 2) Narrow directivity response.
- 3) Quick response.
- 4) Excellent linearity.
- 5) High reliability.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● セレクションガイド/Selection Guide

2P3-60	○ : 標準品
--------	---------

● 用途

ホトセンサ
光スイッチ

● Applications

Photo sensor
Photoconductive switch

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{ECO}	30	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
動作温度範囲	T_{opr}	-30~125	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

● 電氣的・光学的特性/Electrical-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
暗電流	I_D	—	—	500	nA	$V_{CE} = 10V, E = 0L_{UX}$
光電流	I_L	1.0	—	—	mA	$V_{CE} = 10V, E = 200L_{UX}$
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	30	—	—	V	$I_C = 50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	$I_E = 50\mu A$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	30	—	—	V	$I_C = 50\mu A$
直流電流増幅率	h_{FE}	600	—	1600	—	$I_C = 2mA, V_{CE} = 5V$
ピーク分光感度	λ_P	—	800	—	nm	$V_{CE} = 10V$

● 電氣的・光学的特性曲線/Electrical-Optical Characteristic Curves

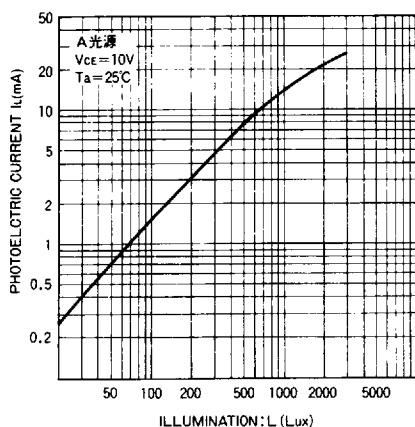


Fig.1 光電流-照度特性(Typ.)

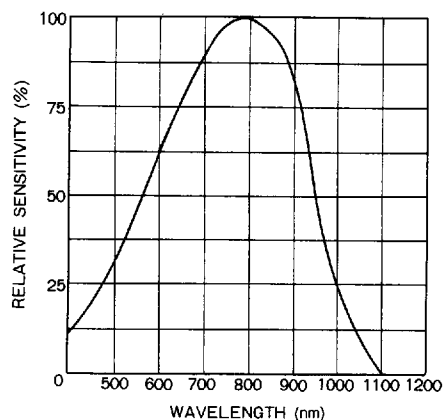


Fig.2 波長感度

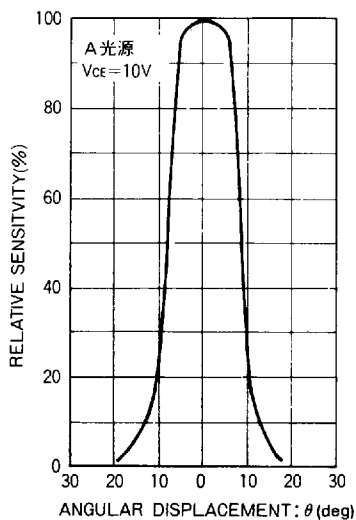


Fig.3 指向感度特性